

256 M ビット コンシューマ FCRAM™

1.8 V, ×64, Low Power DDR SDRAM, SiP 向け

MB81EDS256545

■ 特 長

- 低消費電力と高速データ転送を両立した RAM
- Low Power DDR SDRAM インタフェース
- 1 M ワード× 64ビット× 4バンク構成
- 1.8 V 単一電源 ($V_{DD}=V_{DDQ}$)
- ジャンクション温度 $T_J=-10^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$
- アイドル中にクロック停止が可能
- バーストアクセス毎にオートプリチャージ設定が可能
- ドライバ能力可変機能
- オートリフレッシュ, セルフリフレッシュ
- ディープパワーダウンモード
- 特殊機能
 - マルチ・バンク・アクティブ(MACT)機能
 - マルチ・バンク・プリチャージ(MPRE)機能
 - バックグラウンド・リフレッシュ(BREF)機能
 - スタート・アドレス・シフト(SAS)機能
 - アディショナル・RDQS・トグル(ART)機能

■ 主な仕様

型 格	MB81EDS256545
構 成	1M ワード×64 ビット×4 バンク
インタフェース	Low Power DDR
電源電圧	1.7 V~1.95 V
バースト動作周波数 (最大)	216 MHz
データ転送レート (最大)	3.46G バイト/ 秒
クロックアクセスタイム (最小)	4.6 ns
動作電流 (バーストリード時) (最大)	300 mA
ディープパワーダウン電流 (最大)	20 μA